



# 2025年12月期上半期決算説明

2025年8月7日

代表取締役社長 川上 潤

取締役副社長 尾形 潔



**Rigaku**

視るチカラで、世界を変える

本資料は、リガク・ホールディングス株式会社（以下「当社」といいます）の企業情報等の提供のために作成されたものであり、米国、日本国またはそれ以外の一切の法域における当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。米国、日本国またはそれ以外の一切の法域において、適用法令に基づく登録若しくは届出またはこれらの免除を受けずに、当社の有価証券の募集または販売を行うことはできません。

本資料には、当社または当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述には、「予想」、「予測」、「予定」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」やこれらの類義語が含まれることがありますが、これらに限られるものではありません。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報をもとに、本資料の作成時点における当社の判断に基づいて記載したものであり、また、一定の前提・仮定の下になされています。そのため、これらの記述または前提・仮定は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の結果はこれと大幅に異なる可能性があります。このリスクや不確定要素には、例えばX線分析機器の需要の悪化、当社のブランド、製品およびサービスに関するレピュテーション、市場における競争状況、海外事業展開に伴うリスク、物価変動、為替変動、労働コストの変動、規制動向、事業成長戦略の遂行可能性、個人情報・機密情報の保護、裁判手続等の動向、大規模災害の発生その他の要因が含まれます。

当社の現在の決算期は12月末であります。また、当社は、2022年1月1日を移行日として、2022年12月期より国際財務報告基準（以下「IFRS」といいます）を採用しております。

本資料には、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後営業利益、調整後営業利益率、研究開発費比率、設備投資額比率、調整後当期利益、フリーキャッシュ・フローなど、当社のNon-IFRS指標に関する記述がありますが、これらはIFRS、日本基準その他の会計基準に基づく財務数値に代替するものではありません。かかるNon-IFRS指標の当社における使用、定義および算定は、他社における同様の名称の財務指標とは大きく異なる可能性があり、直接的に比較することはできません。これらの財務数値の算出根拠等の詳細についてはAppendixをご参照ください。また、本資料には、製品区分別売上収益および営業利益並びにエンドマーケット別売上収益等の管理会計ベースの財務情報が含まれています。当該財務情報は日本基準またはIFRSに基づき作成されたものではなく、監査を受けたものでもありません。

なお、本資料における記述は本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。そのため、本資料に記載されている将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業等に関する情報は、公開情報または第三者が作成したデータ等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について、当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。

## 【アジェンダ】

1. 2025年12月期上半期連結決算概要
2. 2025年通期業績予想のアップデートと成長戦略の進捗

# 2025年12月期上半期連結決算概要

---

## 全社

- 半導体は引き続き堅調。多目的分析機器事業のサイクルと部品事業(EUV)停滞により売上は前年同期比▲4.7%。R&D、コマーシャルインフラへの戦略投資は継続し、調整後EBITDAおよび調整後当期利益は前年同期比で減少
- パイプラインは堅調に伸長(前年同期比+15%)。中期的な需要の底堅さは変わらず
- 期初想定外の市場変化(トランプ政策の影響、EUVの一時的な投資抑制)による通年業績への影響を確認

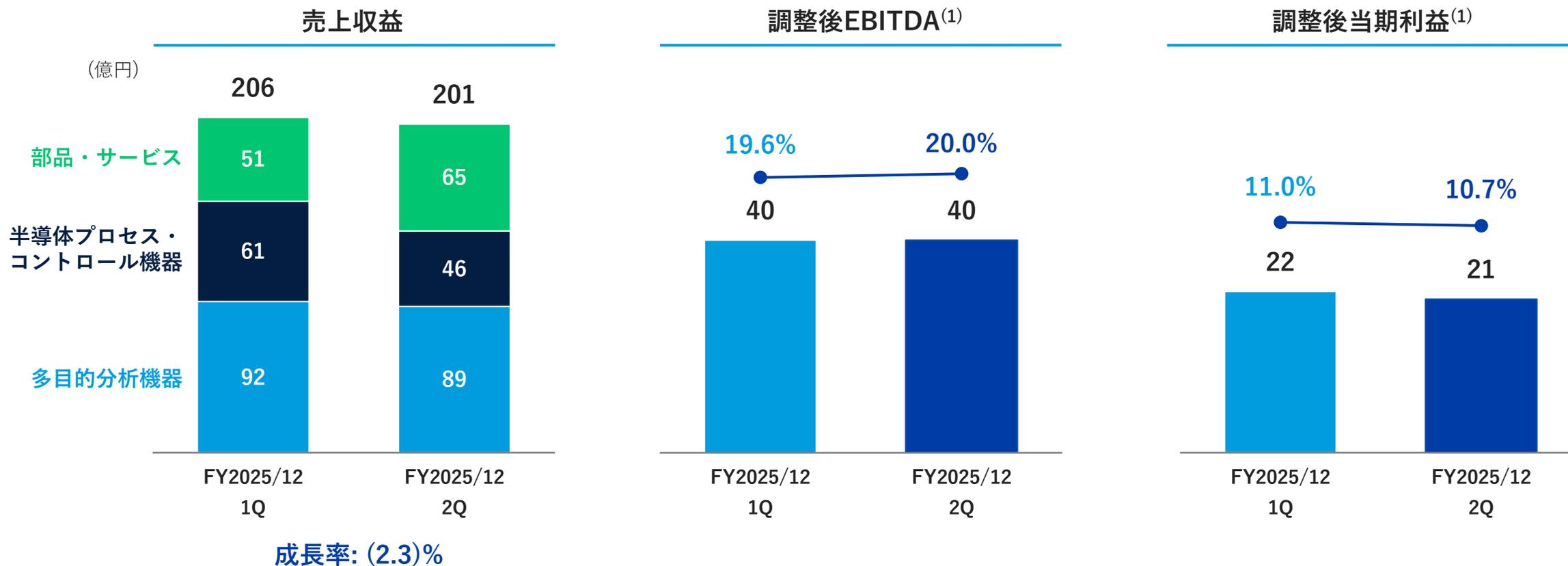
## 多目的 分析機器

- 前年同期比では中国補正予算案件剥落と日本の大型案件サイクルが一段落したことで売上▲14%。一方で、欧州・アジア・米州は伸長継続
- 期初予算比では米州を除く全ての地域で堅調。日本も通期予想達成に向けて進捗中

## 半導体 プロセス・ コントロール 機器

- 売上は前年同期比+17%
- メモリ量産投資やWFE大型案件等に一部遅延/期ズレが発生しているが、開発投資需要は旺盛で通年ベースでの需要は堅調に推移

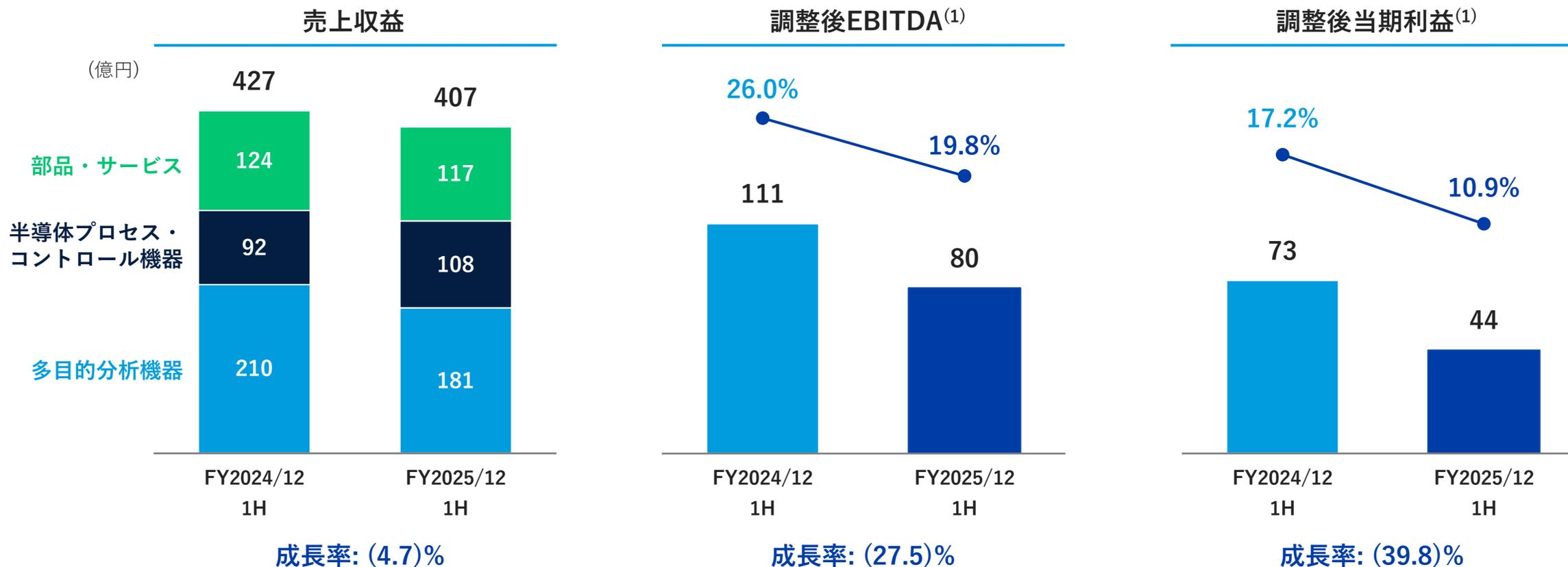
- 半導体プロセス・コントロール機器事業の量産投資遅れの影響により、売上は前四半期比で伸び悩み
- 調整後EBITDA<sup>(1)</sup>、調整後当期利益<sup>(1)</sup>は、ほぼ前四半期水準



注：

1. Non IFRSの項目算出に関する調整項目についてはPage27、28に詳細を記載

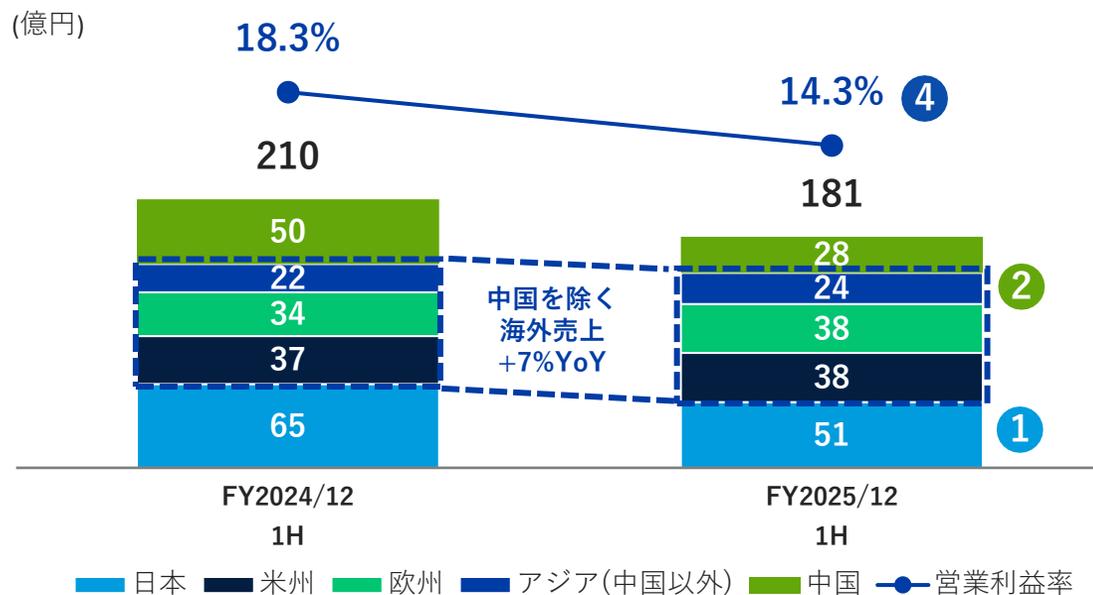
- 半導体プロセス・コントロール機器は増加も、他事業が減少し、売上全体は前年同期比▲4.7(実質▲3.1%)
- 売上減と戦略的なR&Dおよびインフラ投資継続により、調整後EBITDA<sup>(1)</sup>・調整後当期利益<sup>(1)</sup>は前年同期比で減少



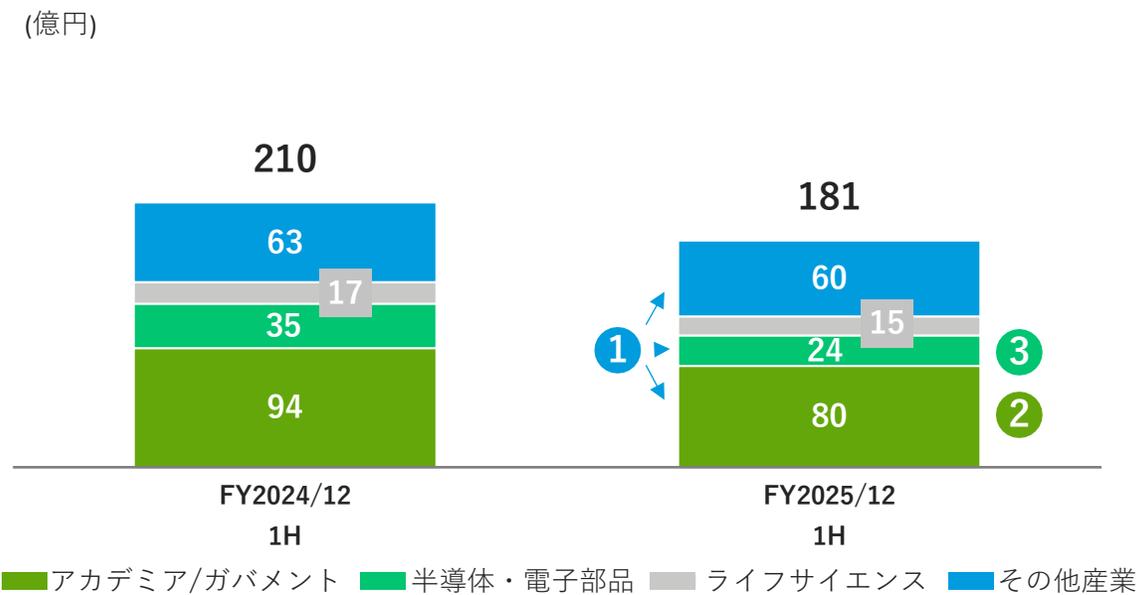
注：  
1. Non IFRSの項目算出に関する調整項目についてはPage27、28に詳細を記載

- 売上は前年同期比▲14%
- 但し、グローバル戦略は引き続き奏功し、中国を除く海外売上は前年同期比+7%成長

地域別売上収益



エンドマーケット別売上収益



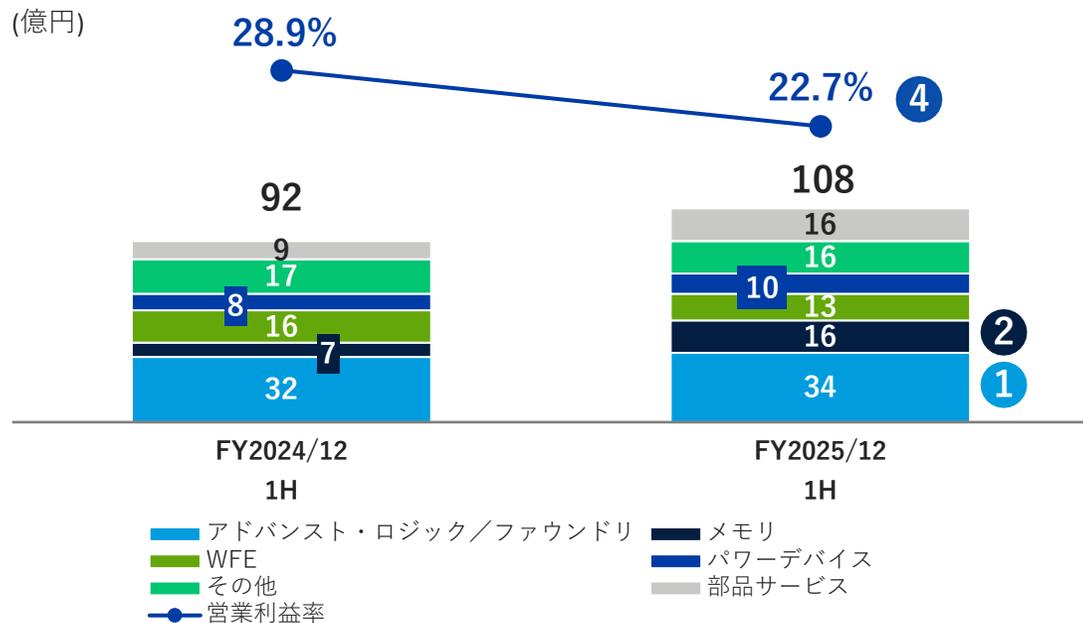
- ① 日本：前年1Qに大型案件(電池、電子部品、アカデミア)が集中した反動から売上減となるが、下期に向け予定通り回復基調
- ② 中国：補正予算案件剥落により売上減。上期計画には織り込み済みで、期初予想に対する進捗は順調
- ③ パワー半導体向け大型製品：SiC市場環境変化で売上減。但し、2026年に向け、中国(SiC)/日欧(GaN)でパイプライン伸長
- ④ GPマージン<sup>(1)</sup>率は価格コントロール、製品ミックスにより向上(+1.8pts)するが、売上の減少により営業利益率は低下

注：

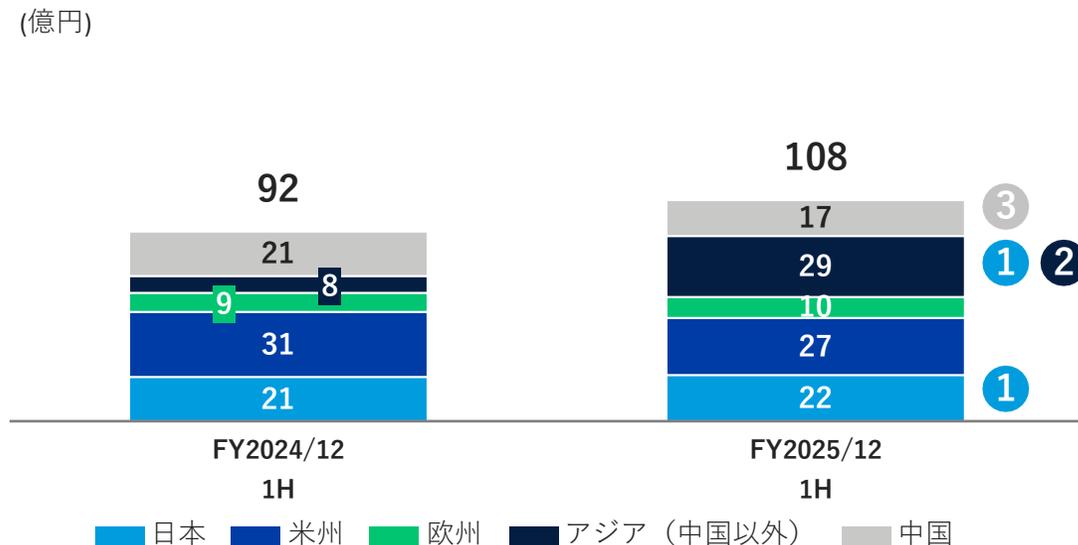
1. 2025年第1四半期連結会計期間より、従来販売費及び一般管理費で計上していた販売先での納入等フィールドサービス関連費用を売上原価に計上する方法へ変更。本資料では当該変更を前年同期についても遡及適用

- 売上は前年同期比+17%
- 量産投資の遅れによる期ズレ発生。旺盛な開発ニーズにより、年間の需要は引き続き堅調

アプリケーション別売上収益

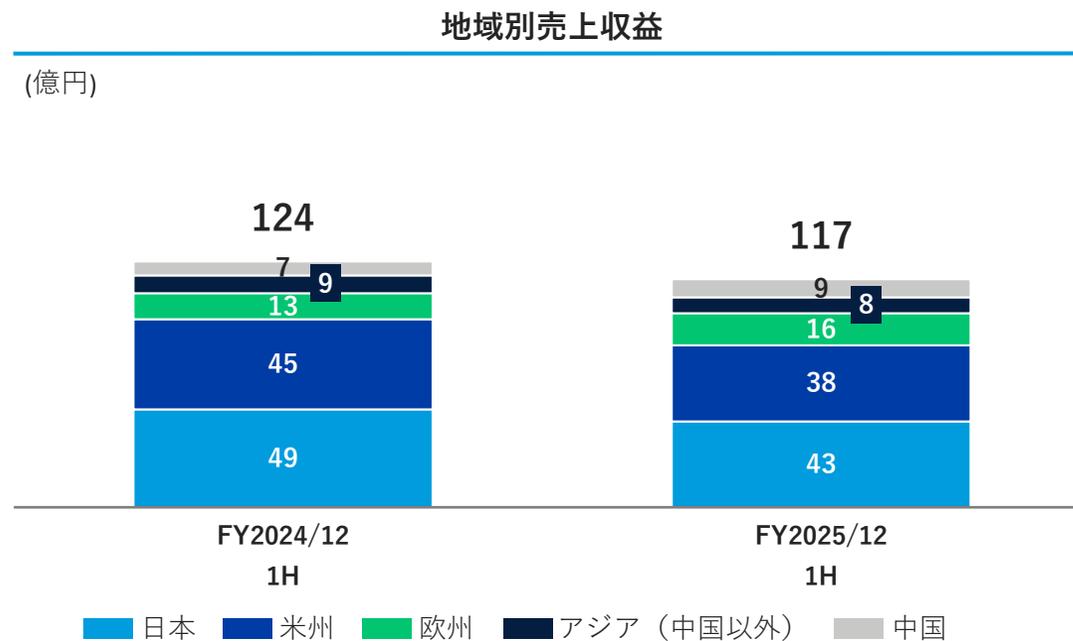
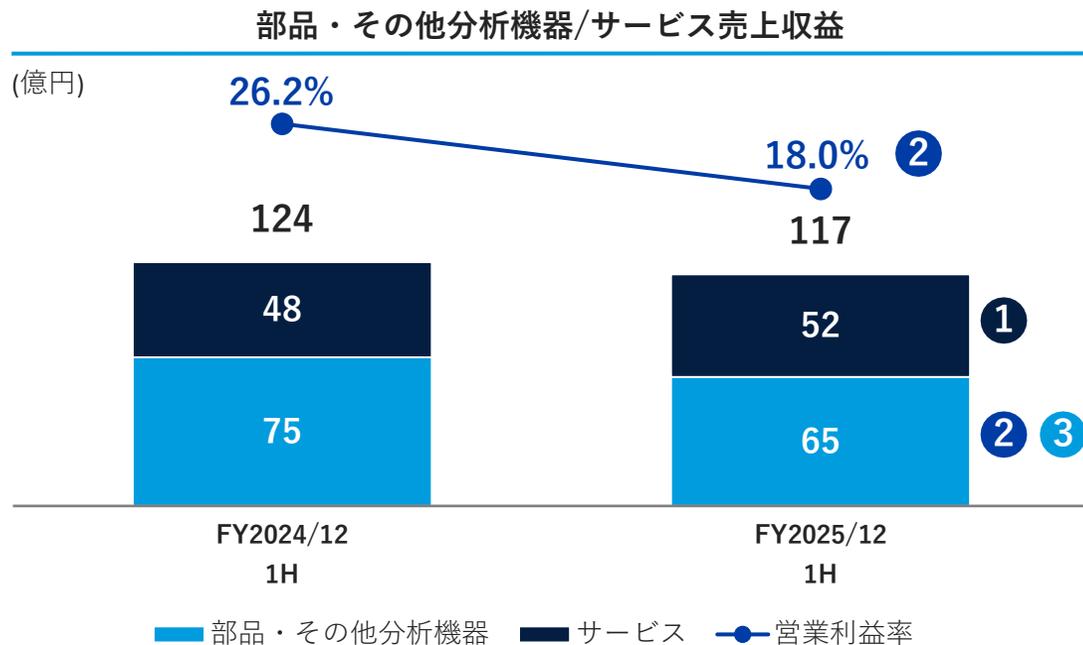


地域別売上収益



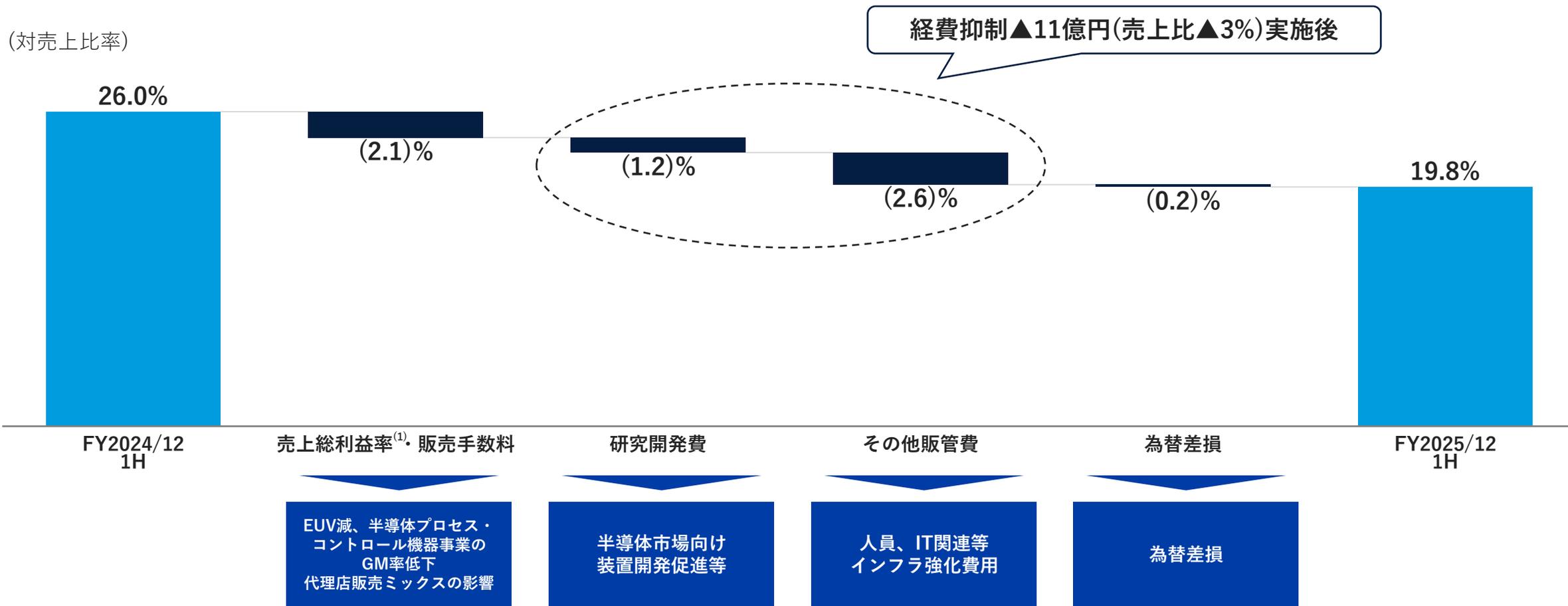
- ① ロジック：AI半導体需要の拡大を背景に、アジア・日本で売上が伸長
- ② メモリ：アジアではDRAM・NANDが牽引し前年対比伸長するも、量産投資タイミングに遅れあり
- ③ 中国：グローバル・プレーヤーの投資再開/加速により、中国売上比率は16%と計画を上振れ
- ④ 地域・製品ミックスの影響により1Hの営業利益率は低下。但し、年間ではミックス改善とボリューム増により30%超の営業利益率を予定

- EUV向け多層膜ミラーの需要減速により売上は全体で前年同期比▲6%。EUVを除けばフラット
- サービス売上は+7%の成長



- ① サービス：価格引き上げとグローバルでの保守サービス契約の拡販、インストールベースの増大により+7%増加
- ② EUV向け多層膜ミラー：売上(▲7億円)。営業利益率の低下に影響。2Hでの回復は見込みにくい状況
- ③ 部品・その他分析機器：2Qは前年を上回る売上(+5億円)と回復傾向

- 1Hは地域・製品ミックスによるGPマージンの低下が響き、R&D・インフラへの戦略的投資を一部抑制したものの、調整後EBITDAマージンは約20%に低下



注：

1. 2025年第1四半期連結会計期間より、従来販売費及び一般管理費で計上していた販売先での修理・納入等フィールドサービス関連費用を売上原価で計上する方法に変更。本資料では当該変更を前年同期についても遡及適用(674百万円を販売費及び一般管理費から売上原価に変更)して表示

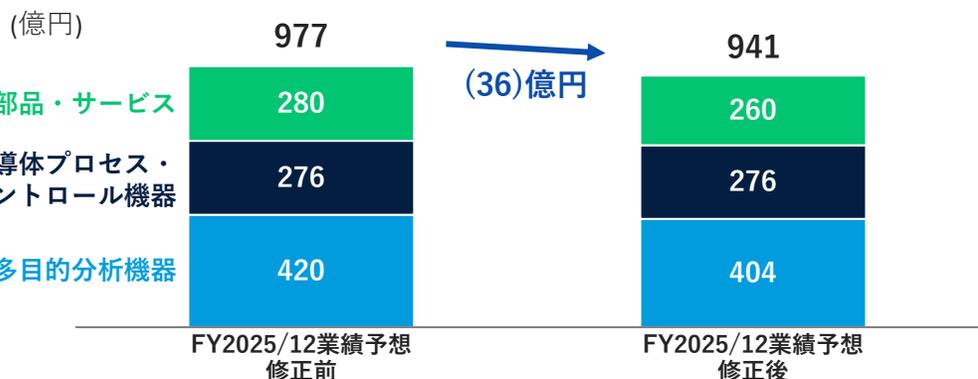
# 2025年通期業績予想のアップデートと成長戦略の進捗

---

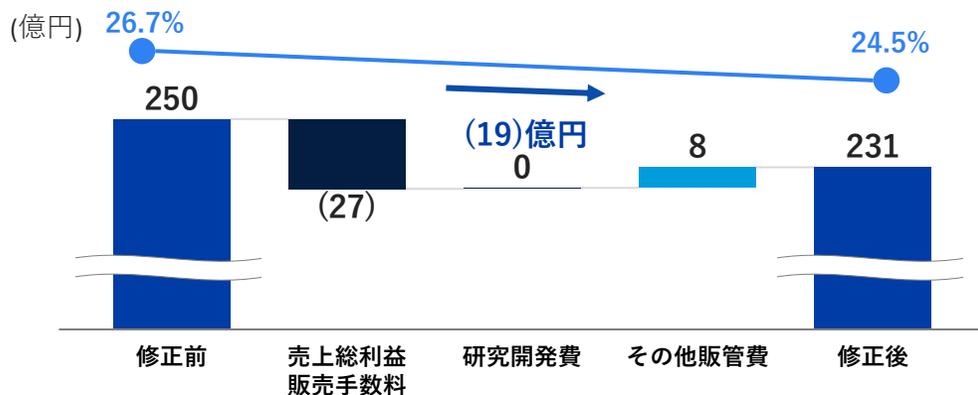
- 足元の事業環境に鑑み、2025年度業績予想を小幅に下方修正(売上収益の実質成長率(YoY)：10%⇒6%)
- トランプ政策によるアカデミア分野を中心とした米州市場への影響、EUV向け多層膜ミラーの短期的な需要調整が主因。一方で半導体プロセス・コントロール機器事業の見込みは不変

業績予想修正サマリー

製品別売上収益



調整後EBITDA



多目的分析機器

▲16億円

- ・米政策影響に伴うアカデミア領域における歳出削減等の影響を織込み(▲19億円)
- ・成長分野における取組み強化、Pillar 3戦略の加速を通じたパイプライン創出を継続

半導体プロセス・コントロール機器

不変

- ・売上成長は当初業績予想から不変、前年比実質+20%の成長を維持
- ・量産から次世代テクノロジーの研究開発へシフトするが、年間目標の達成に向けて順調に推移

部品・サービス

▲20億円

- ・EUV向け多層膜ミラーの需要スローダウン等による部品減収見込み(▲18億円)
- ・米政策は米州アカデミアのサービス事業にも影響(▲2億円)

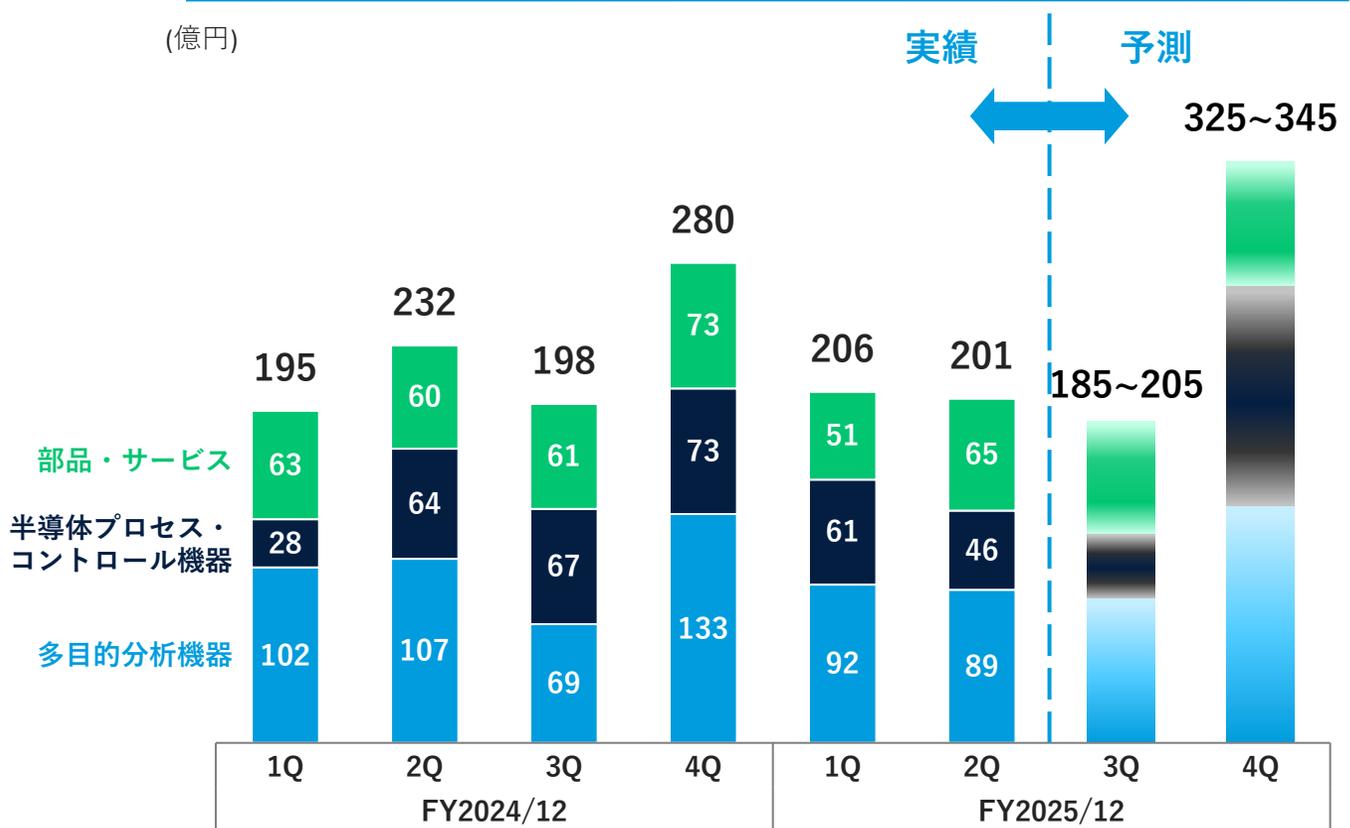
調整後EBITDA

- ・売上総利益は主に米国における多目的分析機器およびEUVの売上減による低下
- ・R&D投資は継続。その他販管費コントロールにより+8億円

リガクの成長性と戦略の有効性は不変

- 昨年と同様、4Q偏重の季節性と半導体プロセス・コントロール機器の量産⇒研究開発需要のシフトにより、特に売上は4Qに大きく成長する見込み
- 製造キャパシティの増強と製造リードタイムの改善が、この成長の実現を支える

四半期毎売上 業績予想修正後

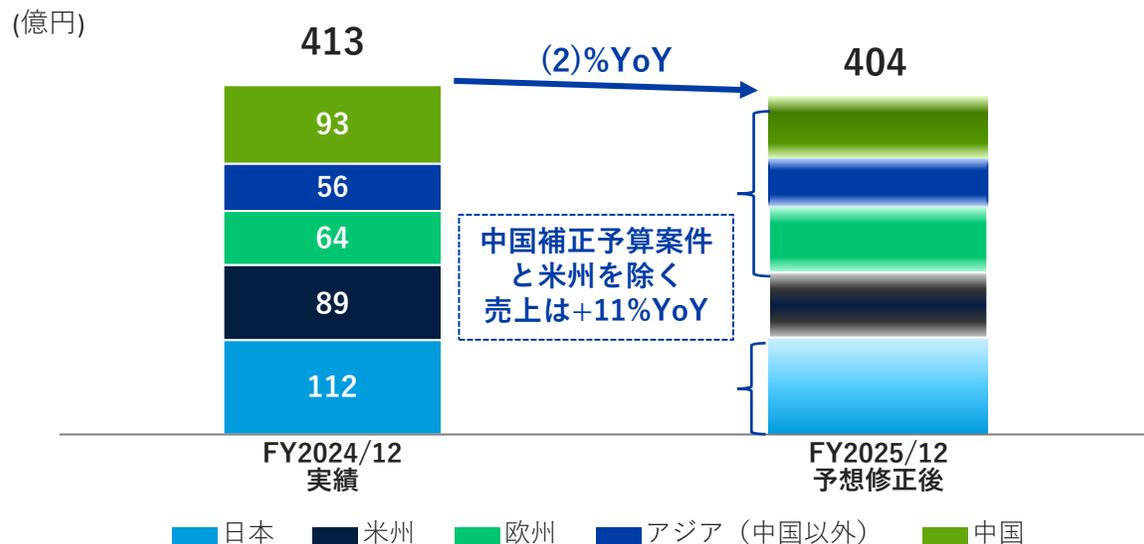


部品・サービス	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EUV向け多層膜ミラーの需要低迷は継続するも、その他分析機器は、ほぼ期初計画通り</li> <li>• サービスは米州以外は堅調に伸長</li> </ul>
半導体プロセス・コントロール機器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 量産から研究開発需要へのシフトにより、売上は4Qに集中する見込み</li> <li>• 案件の進捗は順調、製造スロットは確保済み</li> </ul>
多目的分析機器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• グローバル戦略、Pillar 3戦略の進展により、米州を除く地域での需要が伸長。日本も含め4Qにかけて売上が拡大</li> </ul>

## 業績予想アップデートのポイント

- 米政策影響を織り込み、売上を前年比 ▲2%(為替影響を除くと対前年比フラット)に修正。修正後CAGR(FY22~25)は18%
- 中国の補正予算案件と米州を除く売上は対前年比+11%見込み
- 成長分野での取り組み、グローバル戦略、Pillar 3戦略を推進し持続的な成長継続

## 地域別売上(2024年度実績 vs 2025年度修正後予想)



## 成長分野の取り組み/Pillar 3戦略の加速

### Fab向けソリューションの拡充

- 回折(MiniFlex XpC)と蛍光のハイブリッド自動化を実現
- 蛍光自動化モデル(ZSX Primus IV/III NEXT)による中国セメント市場の戦略的開拓

### 半導体/電子部品

- XRTmicron/TFXRDのFab対応と生産体制強化完了

### 電池

- 全固体電池：研究機関・企業と連携。R&D, QA/QC向け開発を推進
- ペロブスカイト太陽電池：自動測定技術で高効率評価システムの構築に貢献中
- 大阪公立大イノベーションアカデミー・スマートエネルギー棟に5製品導入

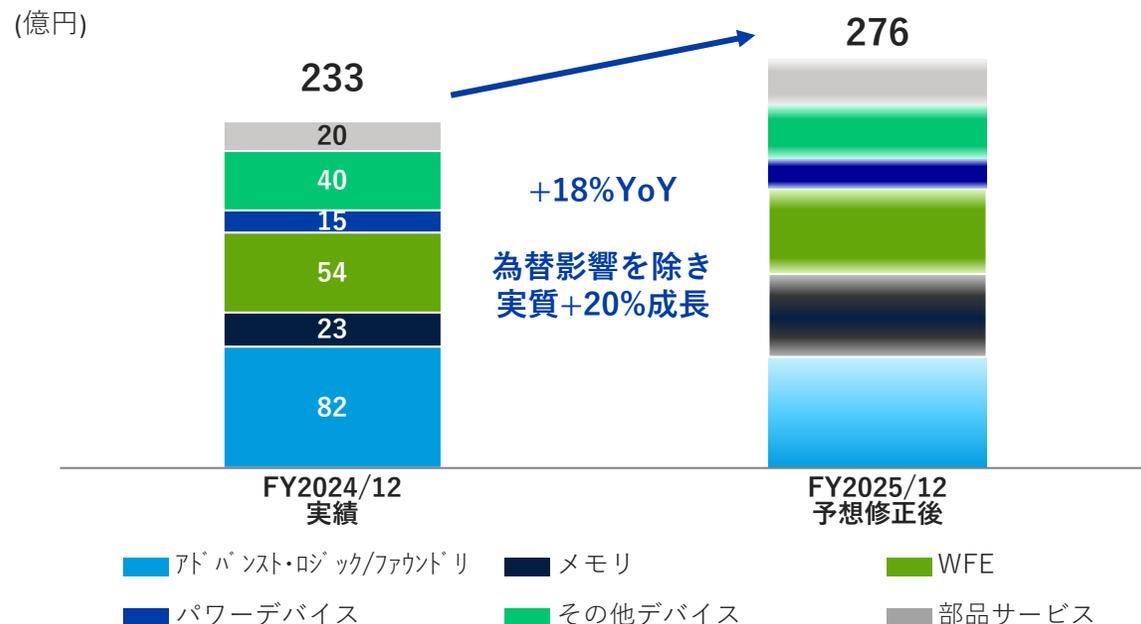
### ライフサイエンス

- XtaLAB Synergy-ED(電子線回折)：製薬企業とのコラボで市場拡大中
- 新技術(電子密度トポグラフィー)：大阪公立大に初号機納入。米国ボストン拠点と併せて国内外でライフサイエンス業界へ浸透

## 業績予想アップデートのポイント

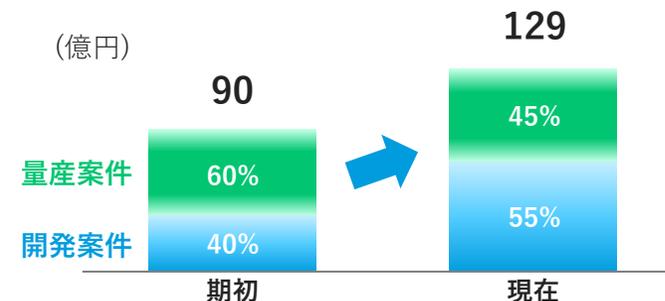
- 売上収益は当初業績予想から修正なし、実質+20%の成長
- 量産から開発への需要のシフトにより、アプリケーション別ではアドバンスト・ロジック/ファウンドリの割合が増加
- 先端半導体計測技術開発は予想を上回るペースで進捗  
26年以降のさらなる飛躍に自信を深める

## アプリケーション別売上(2024年度実績 vs 2025年度修正後予想)



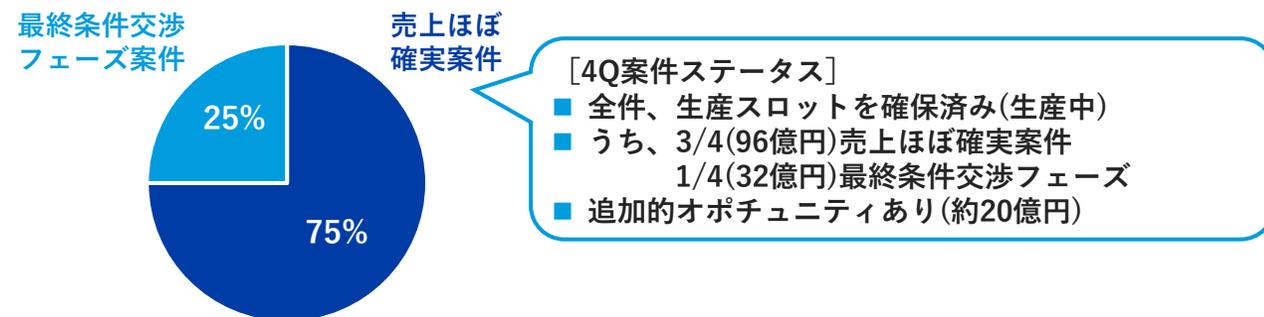
## 4Qに売上が集中する要因と対応の状況

- 量産から開発への需要構造の変化を受け、売上の4Q比重が高まる  
【4Q売上予想】



- ① 半導体市況が想定を下回り、NAND・パワーデバイス等での量産案件が減少：3Q累計で▲約30億円
- ② 一方、AI半導体向け次世代ロジック・HBM(DRAM)研究開発目的の需要を捕捉し4Qの売上が向上：+約38億円(一部、3Q以前からの期ズレ案件を含む)

- 4Q売上の構成(現時点)



■ 現行製品ポートフォリオに加え、2026、27年に相次いで新製品のローンチを計画し、新市場を創出

先端計測ニーズ	開発／上市ロードマップ			想定SAM(目標シェア) @2030	進捗
	2025年	2026年	2027年		
<b>ロジック</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GAA/CFET 3D構造形状計測</li> </ul>	次世代ロジック XTRAIA CD-3200G(低エネルギーGI-SAXS) 開発中	★ 本格量産開始	新市場 100M\$(>50%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>CD-3000G販売中</li> <li>低E版CD-3200G開発中</li> </ul>
<b>ロジック・メモリ共通</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si/SiGe超格子計測</li> <li>High-k/Metal Gate 超薄膜計測</li> <li>軽元素超薄膜計測</li> </ul>	次世代ロジック・メモリ共通 XTRAIA XD (HR-XRD) 顧客評価中	★ 本格量産開始	100M\$(>70%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>開発完了、大手ファウンドリ・メモリで採用</li> <li>次世代機(GEN4)開発中</li> <li>軽元素XRF開発完了、製品化中</li> </ul>
		XTRAIA MF-3400(XRF/XRD複合機GEN4) 開発中	★ 本格量産開始	200M\$(>70%)	
		ONYX 3200 開発中	★ 本格量産開始	新市場 100M\$(>50%)	
<b>メモリ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DRAM/NAND HAR(深孔)計測</li> </ul>	次世代メモリ XTRAIA CD-3200(T-SAXS) 顧客評価	★ 本格量産開始	100M\$(>50%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>大手メモリ・WFE採用</li> </ul>
<b>アドバンスド・パッケージング</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HBM/CoWoS等の先端パッケージの微細バンプ/TSV等の欠陥検査</li> </ul>	AXI(Advanced X-ray Inspection)アルファ機デモ中 ベータ機開発中	ベータ機顧客評価 ★ 本格量産開始	300M\$(>30%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>アルファ機デモ中</li> <li>ベータ機開発中</li> </ul>
<b>Hybrid Metrology</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ロジック、メモリ立体構造形状計測</li> </ul>	T-SAXS 顧客評価 X線と光学手法を組み合わせ解析するハイブリッド・エンジン開発中	★ 本格量産開始 GI-SAXS：開発予定	新市場 100M\$(>50%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>光学パートナーと共同開発</li> </ul>

## 自己株式取得について

当社では、現在の株価水準は当社の将来の収益性を十分に織り込んでいないと認識しており、持続的な企業価値向上に向けた取り組みの一環として、また資本政策及び株主還元策強化の観点から、自己株式を最大40億円取得する方針

- 取得対象株式の種類：普通株式
- 取得し得る株式の総数：6,000,000株(上限)  
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.62%)
- 株式取得価額の総額：4,000百万円(上限)
- 取得期間：2025年8月8日～2025年12月23日
- 取得方法：東京証券取引所における市場買付け(取引一任契約)

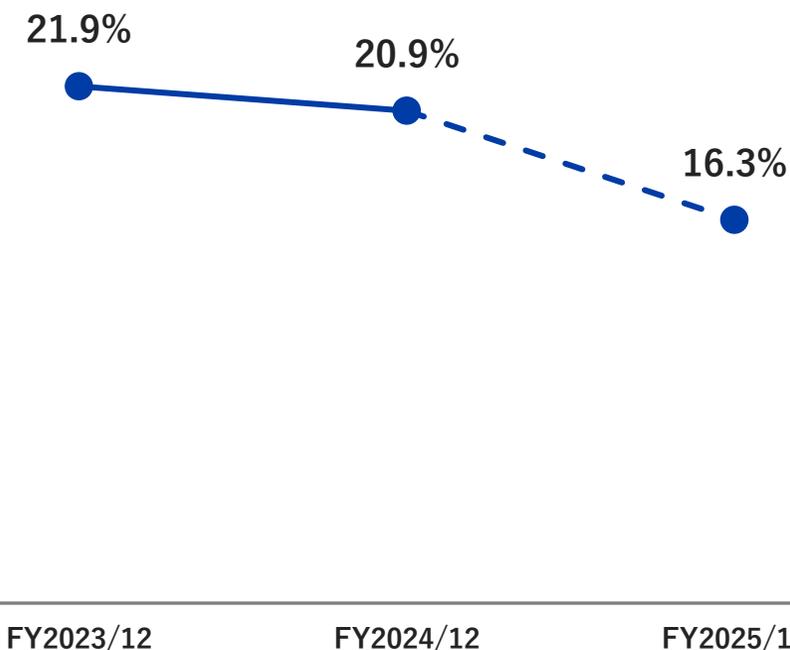
## 配当性向について

当社は、中長期の経営視点から成長投資の推進と財務健全性の確保とのバランスを考慮しつつ、各期の業績に応じて当期連結利益の30%を目途に株主への配当を実施していくことを、引き続き基本方針とする

- 2025年上期の配当は計画通り1株当たり9.4円
- 2025年通期の配当は当初計画通り1株当たり18.8円とする予定

注：  
1. ROE = 調整後税引後当期純利益 ÷ 自己資本(期初期末平均)

## 調整後自己資本利益率<sup>(1)</sup>(ROE)推移



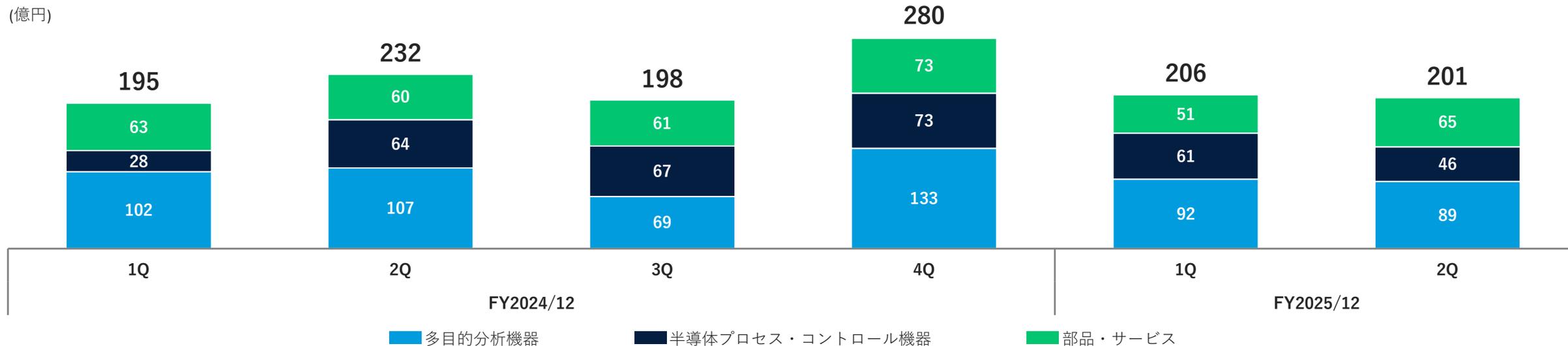
- 25年通期業績予想は、トランプ政策による米国アカデミア市場の短期的動向と、一時的なEUV向け需要減を反映し小幅修正
- 半導体プロセス・コントロール機器事業は実質20%成長で不変
- 中国補正予算の影響と米州を除けば多目的分析機器事業も二桁成長を目標
- 半導体領域での技術進化・新素材開発に伴うX線計測・検査需要は想定を超える勢い
- リガクの中長期成長見通し、及び基本戦略には変化無し
- 業績予想の確実な達成と成長戦略の加速に注力。また、自己株式40億円の取得を実施予定

# Appendix - 2025年12月期上半期連結決算

---

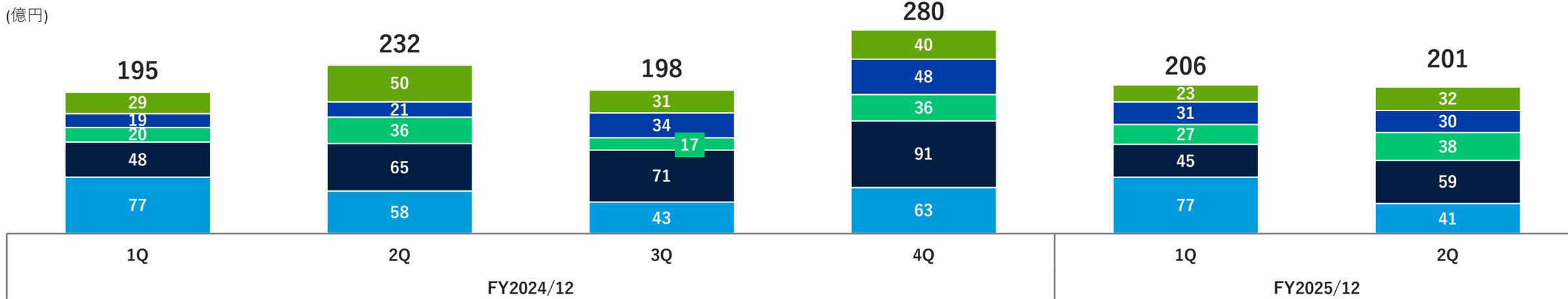
(百万円)	売上収益				営業利益				営業利益率		
	FY2024/12 2Q累計	FY2025/12 2Q累計	増減	増減率	FY2024/12 2Q累計	FY2025/12 2Q累計	増減	増減率	FY2024/12 2Q累計	FY2025/12 2Q累計	増減
多目的分析機器	21,029	18,184	(2,845)	(13.5)%	3,851	2,592	(1,259)	(32.7)%	18.3%	14.3%	(4.1)pts
半導体プロセス・ コントロール機器	9,286	10,824	1,538	16.6%	2,683	2,455	(228)	(8.5)%	28.9%	22.7%	(6.2)pts
部品・サービス	12,462	11,746	(716)	(5.7)%	3,270	2,110	(1,160)	(35.5)%	26.2%	18.0%	(8.3)pts
本社費	-	-	-	-	(1,132)	(1,440)	(308)	27.2%	-	-	-
<b>売上収益合計</b>	<b>42,779</b>	<b>40,756</b>	<b>(2,023)</b>	<b>(4.7)%</b>	<b>8,672</b>	<b>5,717</b>	<b>(2,955)</b>	<b>(34.1)%</b>	<b>20.3%</b>	<b>14.0%</b>	<b>(6.3)pts</b>

製品別売上収益推移



(百万円)	FY2024/12	FY2025/12	増減	増減率	主たる増減要因
	2Q累計	2Q累計			
売上収益合計	42,779	40,756	(2,023)	(4.7)%	—
日本	13,660	11,845	(1,815)	(13.3)%	多目的分析機器と部品・サービスにおけるEUV向け多層膜ミラーの減収。半導体プロセス・コントロールは微増
米州	11,441	10,532	(909)	(7.9)%	部品・サービスにおけるEUV向け多層膜ミラーの減速、及び半導体プロセス・コントロール前期大型案件の剥落で減収
欧州	5,694	6,579	885	15.5%	主に多目的分析機器における汎用機の好調な販売により増収
アジア(中国以外)	4,046	6,198	2,152	53.2%	主に半導体プロセス・コントロール機器事業が貢献
中国	7,935	5,600	(2,335)	(29.4)%	主に多目的分析機器において前期増加した中国補正予算案件の剥落により減少

## 地域別売上収益推移

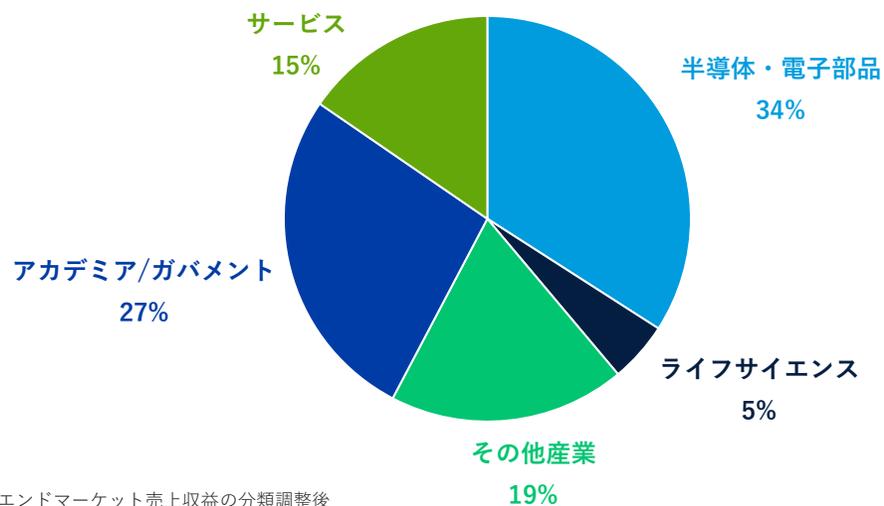


注：  
1. 海外の顧客・代理店に対する売上収益に基づき算出

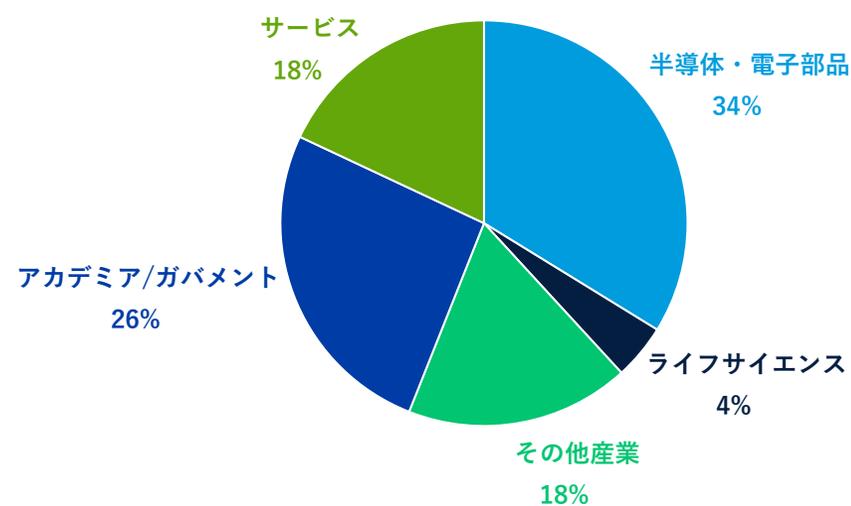
■ 日本 ■ 米州 ■ 欧州 ■ アジア(中国以外) ■ 中国

(百万円)	FY2024/12	売上収益比率	FY2025/12	売上収益比率	コメント
	2Q累計 <sup>(1)</sup>		2Q累計		
売上収益合計	42,779	100%	40,756	100%	—
半導体・電子部品	14,578	34%	13,973	34%	半導体プロセス・コントロール機器の売上が向上するも、EUV向け多層膜ミラーおよび多目的分析機器におけるパワー半導体向け大型製品の売上低下による影響で減少
ライフサイエンス	2,073	5%	1,785	4%	前期に多かった大型案件の反動
その他産業	8,055	19%	7,054	18%	—
アカデミア/ガバメント	11,491	27%	10,614	26%	前期は中国補正予算案件を含み、今期の比率は低下
サービス	6,580	15%	7,328	18%	Installベースの増大による着実な成長

2024/12月期 2Q累計<sup>(1)</sup>



2025/12月期 2Q累計



注：  
1. 過年度分エンドマーケット売上収益の分類調整後

(百万円)	2024/12	2025/12	増減	増減率	主たる増減要因
	2Q累計	2Q累計			
売上収益	42,779	<b>40,756</b>	(2,022)	(4.7)%	半導体プロセス・コントロール機器事業は増収したが、前年度に含む中国補正予算案件の剥落やEUV関連取引の減少等により、多目的分析機器および部品・サービスが低下し、全体で減収
売上総利益(1)	24,413	<b>22,725</b>	(1,687)	(6.9)%	半導体プロセス・コントロール機器事業における地域・販売製品ミックスの影響、およびGM率の高いEUV向け多層膜ミラーの売上減により低下
対売上収益比率	57.1%	<b>55.8%</b>	(1.3)pts	-	
営業利益	8,672	<b>5,717</b>	(2,954)	(34.1)%	売上総利益の低下に加え、戦略的な研究開発費、人員・ITなどのインフラ強化費用、半導体プロセス・コントロール機器事業での代理店販売割合増による販売手数料、および為替差損の増加が影響
対売上収益比率	20.3%	<b>14.0%</b>	(6.2)pts	-	
税引前中間利益	8,445	<b>5,446</b>	(2,999)	(35.5)%	
中間利益	6,508	<b>3,779</b>	(2,729)	(41.9)%	前期の税額控除見積もり(役員退職慰労金等)の影響、および今期の米国売上割合の低下による税率の上昇
<b>Non-IFRS 指標</b>					
調整後中間利益(2)	7,344	<b>4,422</b>	(2,922)	(39.8)%	
調整後EPS	32.6	<b>19.2</b>	(13.4)	(41.1)%	
EBITDA	11,079	<b>8,135</b>	(2,944)	(26.6)%	
調整後EBITDA	11,131	<b>8,067</b>	(3,064)	(27.5)%	
対売上収益比率	26.0%	<b>19.8%</b>	(6.2)pts	-	
研究開発費	3,166	<b>3,520</b>	354	11.2%	研究開発投資促進
対売上収益比率	7.4%	<b>8.6%</b>	1.2pts	-	
設備投資額	2,843	<b>4,094</b>	1,250	44.0%	山梨工場増設およびデモ機の取得
対売上収益比率	6.6%	<b>10.0%</b>	3.4pts	-	
フリーキャッシュ・フロー	4,963	<b>2,848</b>	(2,114)	(42.6)%	
JPY/USD	154.1	<b>147.5</b>	(6.6)	(4.3)%	上期の為替影響額(対前年比)：売上 ▲約7億円、EBITDA ▲約2.5億円
JPY/EURO	166.1	<b>162.2</b>	(3.9)	(2.3)%	

注：

- 2025年第1四半期連結会計期間より、従来販売費及び一般管理費で計上していた販売先での修理・納入等フィールドサービス関連費用を売上原価で計上する方法に変更。本資料では当該変更を前年同期についても遡及適用(1,386百万円を販売費及び一般管理費から売上原価に変更)して表示
- Non-IFRSの項目算出に関する調整項目についてはPage 27、28に詳細を記載

(百万円)	FY2024/12			FY2025/12								
	1Q	2Q	2Q累計	1Q	2Q	前年同期比	増減率	前四半期比	増減率	2Q累計	前年同期比	増減率
売上収益	19,537	<b>23,241</b>	<b>42,779</b>	20,614	<b>20,141</b>	(3,100)	(13.3%)	(473)	(2.3%)	<b>40,756</b>	(2,023)	(4.7%)
売上総利益 <sup>(1)</sup>	10,607	<b>13,806</b>	<b>24,413</b>	11,590	<b>11,135</b>	(2,671)	(19.3%)	(455)	(3.9%)	<b>22,725</b>	(1,688)	(6.9%)
対売上収益比率	54.3%	<b>59.4%</b>	<b>57.1%</b>	56.2%	<b>55.3%</b>	(4.1)pts	-	(0.9)pts	-	<b>55.8%</b>	(1.3)pts	-
営業利益	3,160	<b>5,511</b>	<b>8,672</b>	2,835	<b>2,882</b>	(2,629)	(47.7%)	47	1.7%	<b>5,717</b>	(2,955)	(34.1%)
対売上収益比率	16.2%	<b>23.7%</b>	<b>20.3%</b>	13.8%	<b>14.3%</b>	(9.4)pts	-	0.6pts	-	<b>14.0%</b>	(6.2)pts	-
税引前利益	3,036	<b>5,409</b>	<b>8,445</b>	2,741	<b>2,704</b>	(2,705)	(50.0%)	(37)	(1.3%)	<b>5,446</b>	(2,999)	(35.5%)
当期利益(四半期/中間)	2,185	<b>4,322</b>	<b>6,508</b>	1,918	<b>1,860</b>	(2,462)	(57.0%)	(58)	(3.0%)	<b>3,779</b>	(2,729)	(41.9%)
<b>Non-IFRS 指標</b>												
調整後当期利益(四半期/中間) <sup>(2)</sup>	2,602	<b>4,741</b>	<b>7,344</b>	2,265	<b>2,157</b>	(2,584)	(54.5%)	(108)	(4.8%)	<b>4,422</b>	(2,922)	(39.8%)
対売上収益比率	13.3%	<b>20.4%</b>	<b>17.2%</b>	11.0%	<b>10.7%</b>	(9.7)pts	-	0.3pts	-	<b>10.9%</b>	(6.3)pts	-
調整後EPS	11.6	<b>21.0</b>	<b>32.6</b>	9.8	<b>9.4</b>	(11.7)	(55.5%)	(0.5)	(4.7%)	<b>19.2</b>	(13.4)	(41.1%)
EBITDA	4,334	<b>6,744</b>	<b>11,079</b>	4,030	<b>4,104</b>	(2,640)	(39.1%)	74	1.8%	<b>8,135</b>	(2,944)	(26.6%)
調整後EBITDA	4,355	<b>6,775</b>	<b>11,131</b>	4,030	<b>4,036</b>	(2,739)	(40.4%)	6	0.1%	<b>8,067</b>	(3,064)	(27.5%)
対売上収益比率	22.3%	<b>29.2%</b>	<b>26.0%</b>	19.6%	<b>20.0%</b>	(9.1)pts	-	0.5pts	-	<b>19.8%</b>	(6.2)pts	-
研究開発費	1,449	<b>1,716</b>	<b>3,166</b>	1,653	<b>1,866</b>	150	8.7%	213	12.9%	<b>3,520</b>	354	11.2%
対売上収益比率	7.4%	<b>7.4%</b>	<b>7.4%</b>	8.0%	<b>9.3%</b>	1.9pts	-	1.2pts	-	<b>8.6%</b>	1.2pts	-
設備投資額	520	<b>2,323</b>	<b>2,843</b>	625	<b>3,468</b>	1,145	49.3%	2,843	454.9%	<b>4,094</b>	1,251	44.0%
対売上収益比率	2.7%	<b>10.0%</b>	<b>6.6%</b>	3.0%	<b>17.2%</b>	7.2pts	-	14.2pts	-	<b>10.0%</b>	3.4pts	-
フリーキャッシュ・フロー	1,605	<b>3,357</b>	<b>4,963</b>	489	<b>2,359</b>	(998)	(29.7%)	1,870	382.4%	<b>2,848</b>	(2,115)	(42.6%)
JPY/USD	149.9		<b>154.1</b>	151.2						<b>147.5</b>		
JPY/EURO	162.2		<b>166.1</b>	159.4						<b>162.2</b>		

注：

- 2025年第1四半期連結会計期間より、従来販売費及び一般管理費で計上していた販売先での修理・納入等フィールドサービス関連費用を売上原価で計上する方法に変更。本資料では当該変更を前年同期についても遡及適用(674百万円を販売費及び一般管理費から売上原価に変更)して表示
- Non-IFRSの項目算出に関する調整項目についてはPage 27、28に詳細を記載

(百万円)	FY2024/12	FY2025/12	増減	増減率	主たる増減要因
	期末	2Q末			
流動資産	71,228	<b>68,620</b>	(2,608)	(3.7)%	前年度期末からの営業債権等の回収による
(現預金)	27,992	<b>28,959</b>	967	3.5%	
有形固定資産	19,287	<b>21,588</b>	2,301	11.9%	山梨工場増設、デモ機の取得
無形資産	87,030	<b>87,288</b>	198	0.2%	
資産合計	177,547	<b>177,438</b>	(108)	(0.1)%	
流動負債	29,934	<b>27,727</b>	(2,206)	(7.4)%	期末からの債務支払い、未払法人所得税の支払い、契約負債の減少等による
非流動負債	65,843	<b>66,202</b>	359	0.5%	デリバティブ金融負債の増加
(有利子負債総額)	61,601	<b>61,950</b>	348	0.6%	
純資産	81,769	<b>83,508</b>	1,738	2.1%	中間利益による増加、新株予約権行使による増加、配当金支払による減少、為替換算調整による減少
負債・純資産合計	177,547	<b>177,438</b>	(108)	(0.1)%	
ネットデット/ 調整後EBITDA <sup>(1)</sup>	1.4x	<b>1.6x</b>	-	-	
自己資本比率	46.1%	<b>47.1%</b>	-	-	

(百万円)	FY2024/12	FY2025/12	増減	増減率	主たる増減要因
	2Q累計	2Q累計			
営業キャッシュ・フロー	7,519	<b>6,902</b>	(617)	(8.2)%	売上低下の影響を、債権回収の最善化努力により軽減
投資キャッシュ・フロー	(2,556)	<b>(4,053)</b>	(1,496)	58.6%	山梨工場の増設をはじめとした有形および無形固定資産の増加
フリーキャッシュ・フロー	4,963	<b>2,848</b>	(2,114)	(42.6)%	
財務キャッシュ・フロー	(1,196)	<b>(416)</b>	780	(65.2)%	長期借入および新株予約券行使による収入、配当金支払
為替換算差異	1,560	<b>(1,464)</b>	(3,025)	-	- 現金および現金同等物の為替換算差額
ネットキャッシュ・フロー	5,326	<b>967</b>	(4,358)	(81.8)%	

注：

1. 2025年12月期第2四半期末の値はLTM合計の調整後EBITDAを用いて算出

(百万円)	FY2024/12	FY2025/12	増減
<b>EBITDA</b>	<b>2Q累計</b>	<b>2Q累計</b>	
税引前中間利益	8,445	5,446	(2,999)
減価償却費及び償却費	2,448	2,428	(20)
支払利息	335	490	154
受取利益及び配当金	(150)	(229)	(79)
<b>EBITDA</b>	<b>11,079</b>	<b>8,135</b>	<b>(2,943)</b>
利益率	25.9%	20.0%	(5.9)pts
<b>調整後EBITDA</b>	<b>2Q累計</b>	<b>2Q累計</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>11,079</b>	<b>8,135</b>	<b>(2,943)</b>
コンサルティング・フィー	15	0	(15)
中国免除申請関連費用	0	(68)	(68)
上場関連費用	37	0	(37)
<b>調整項目計</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>(120)</b>
<b>調整後EBITDA</b>	<b>11,131</b>	<b>8,067</b>	<b>(3,064)</b>
利益率	26.0%	19.8%	(6.2)pts

(百万円)	FY2024/12	FY2025/12	増減
	2Q累計	2Q累計	
<b>調整後営業利益</b>			
<b>営業利益</b>	<b>8,672</b>	<b>5,717</b>	<b>(2,954)</b>
PPA償却費	1,189	1,030	(159)
コンサルティング・フィー	15	0	(15)
中国免除申請関連費用	0	(68)	(68)
上場関連費用	37	0	(37)
<b>調整項目計</b>	<b>1,242</b>	<b>962</b>	<b>(279)</b>
<b>調整後営業利益</b>	<b>9,914</b>	<b>6,680</b>	<b>(3,234)</b>
利益率	23.2%	16.4%	(6.8)pts
<b>調整後中間利益</b>	<b>2Q累計</b>	<b>2Q累計</b>	
<b>中間利益</b>	<b>6,508</b>	<b>3,779</b>	<b>(2,729)</b>
PPA償却費	1,189	1,030	(159)
コンサルティング・フィー	15	0	(15)
中国免除申請関連費用	0	(68)	(68)
上場関連費用	37	0	(37)
<b>調整項目計</b>	<b>1,242</b>	<b>962</b>	<b>(279)</b>
調整項目に対する税金等調整	(405)	(318)	87
<b>調整後中間利益</b>	<b>7,344</b>	<b>4,422</b>	<b>(2,921)</b>
利益率	17.2%	10.9%	(6.3)pts

## Appendix - 2025年度業績予想のアップデート

---

	2024年12月期	2025年12月期	
	実績	業績予想修正前	業績予想修正後
売上収益	906億円	977億円	941億円
前年比成長率	13.5%	7.8%	3.8%
調整後EBITDA	234億円	250億円	231億円
調整後EBITDAマージン	25.9%	25.7%	24.5%
調整後営業利益	209億円	220億円	201億円
調整後営業利益率	23.0%	22.6%	21.4%
調整後当期利益	153億円	154億円	136億円
調整後当期利益率	17.0%	15.8%	14.5%
研究開発費比率	7.5%	8.1%	8.3%
設備投資額比率	7.0%	8.7%	9.7%
要員数	2,136人	2,308人	2,292人
1株当たり配当金	3.0円	18.8円	18.8円
JPY/USD	152.2	145.0	145.0
JPY/EURO	164.4	156.0	156.0

(億円)	売上収益				営業利益				営業利益率		
	FY2024/12 実績	FY2025/12 予想	増減	増減率	FY2024/12 実績	FY2025/12 予想	増減	増減率	FY2024/12 実績	FY2025/12 予想	増減
多目的分析機器	413	404	(9)	(2.2)%	72	64	(8)	(10.9)%	17.4%	16.0%	(1.4)%
半導体プロセス・コントロール機器	233	276	43	18.5%	74	92	18	24.1%	31.8%	33.3%	1.5%
部品・サービス	259	260	1	0.4%	62	47	(15)	(24.1)%	23.9%	18.4%	(5.5)%
本社費	-	-	-	-	(25)	(23)	2	(8.0)%	-	-	-
売上収益合計	906	941	35	3.9%	183	181	(2)	(1.1)%	20.2%	19.3%	(0.9)%

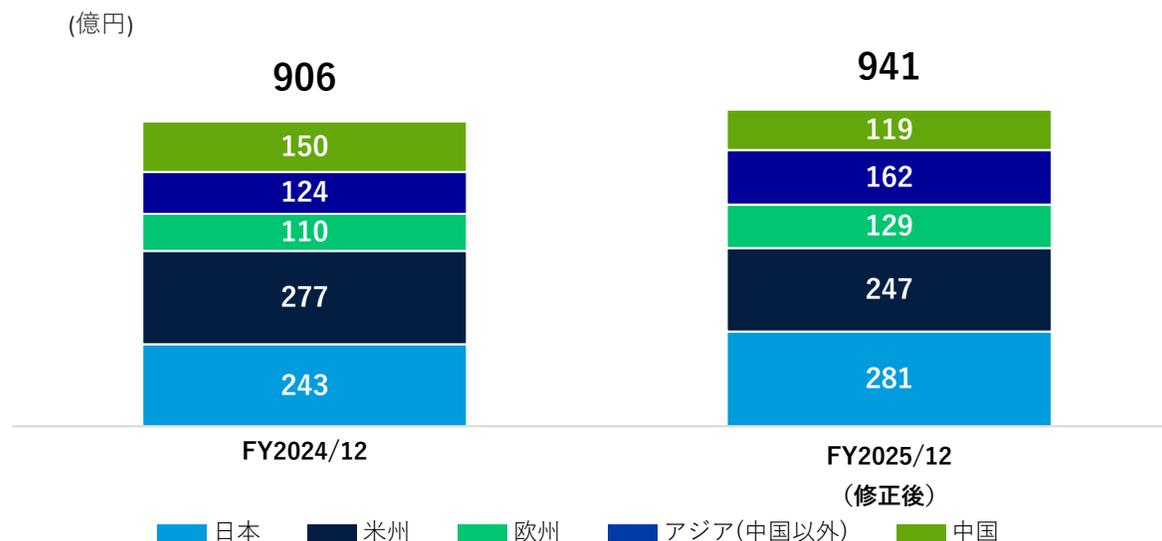
## 営業利益の変動要因

多目的分析機器	1	GPマージン率は価格コントロール、製品ミックスにより向上するが、売上の減少により営業利益率は低下
半導体プロセス・コントロール機器	2	地域・製品ミックスの影響により1Hに低下したものの、年間ではミックス改善とボリューム増により30%超の営業利益を見込む
部品・サービス	3	主に高利益率のEUV向け多層膜ミラーの売上減の影響から営業利益率は低下

注：  
1. 2025年12月期は、1ドル=145円を前提に算出

(億円)	FY2024/12	FY2025/12	増減	増減率	主たる増減要因
	実績	予想			
売上収益合計	906	941	35	3.9%	
日本	243	281	38	15.6%	主に半導体プロセス・コントロール機器事業の売上増によるもの
米州	277	247	(30)	(10.8)%	部品・サービスにおけるEUV向け多層膜ミラー、および米国アカデミア分野の減速
欧州	110	129	19	17.3%	主に多目的分析機器事業にける汎用機の好調な販売により増収
アジア(中国以外)	124	162	38	30.6%	半導体プロセス・コントロール機器事業が牽引
中国	150	119	(31)	(20.7)%	主に多目的分析機器において前期増加した中国補正予算案件の剥落により減少

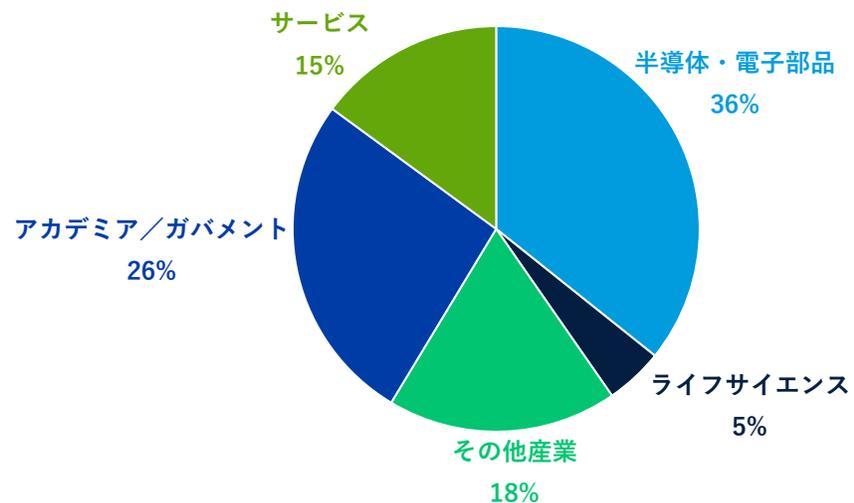
## 地域別売上収益予想



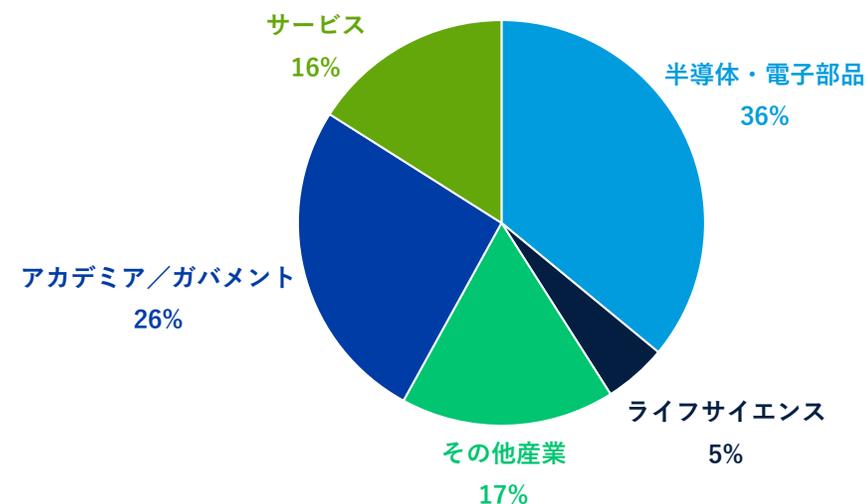
注：  
1. 海外の顧客・代理店に対する売上収益に基づき算出

(億円)	FY2024/12	売上比率	FY2025/12	売上比率	コメント
	実績		予想		
売上収益合計	906	100%	941	100%	
半導体・電子部品	324	36%	337	36%	半導体市場での成長が寄与
ライフサイエンス	41	5%	48	5%	
その他産業	165	18%	156	17%	
アカデミア/ガバメント	239	26%	245	26%	多目的分析機器での米国アカデミア案件が低下する一方で、その他分析機器でのガバメント案件が増加
サービス	135	15%	152	16%	

2024年12月期 通期

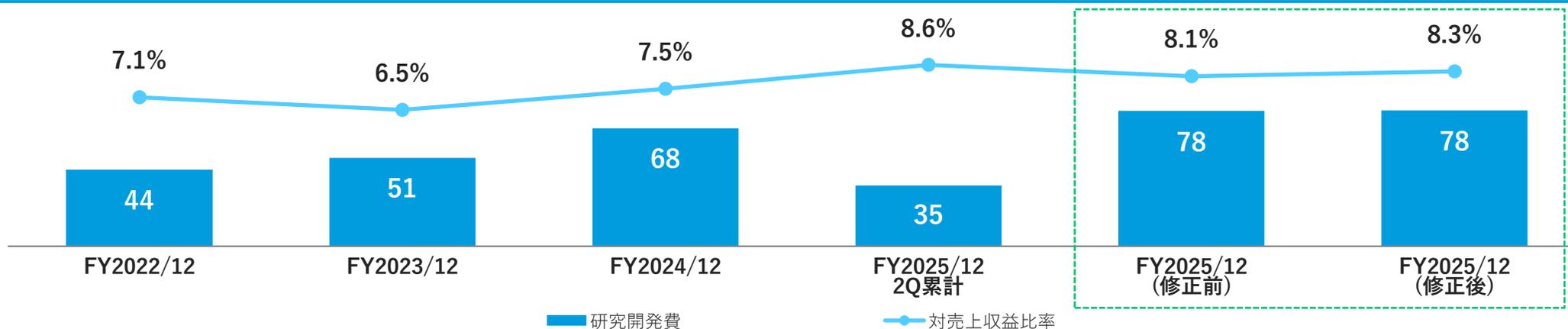


2025年12月期 予想(修正後)

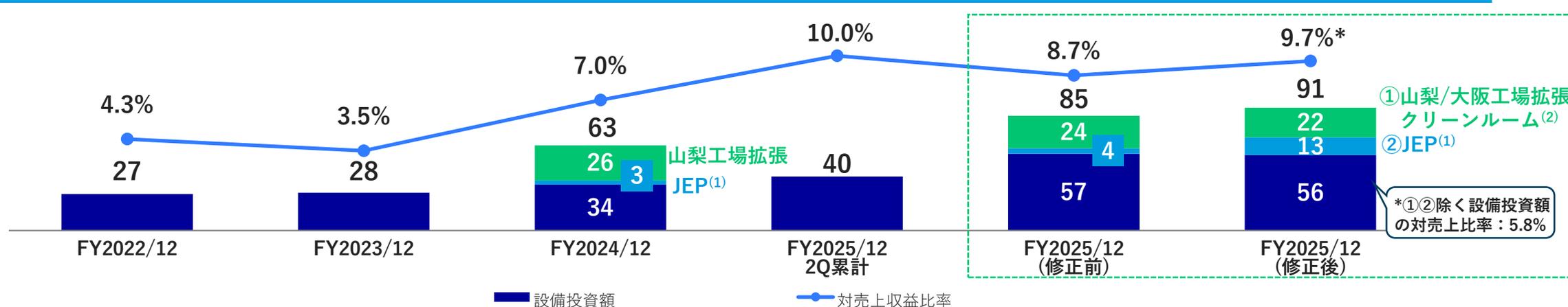


- 研究開発は半導体市場向け、Lab to Fab対応などに戦略的な投資を継続
- 設備投資は工場拡張や社内インフラの拡充を中心に投資を実行

研究開発費推移



設備投資額推移



注：

1. Joint Evaluation Programの略称。新技術の評価を行うために、購入契約に先立ち顧客サイトに装置を導入し、要求される性能を有するかを合同で確認するプロセス。確認できれば当装置の購入に繋がりを、売上計上に伴い固定資産から売上原価に振り替えられる
2. 生産エリア拡張等に関わる使用権資産を除く

(百万円)	FY2024/12	FY2025/12	増減
<b>EBITDA</b>	<b>通期</b>	<b>通期予想(修正後)</b>	
<b>税引前当期利益</b>	<b>17,977</b>	<b>17,397</b>	<b>(580)</b>
減価償却費及び償却費	4,868	5,026	158
支払利息	698	1,080	382
受取利益及び配当金	(363)	(332)	31
減損損失	109	0	(109)
<b>EBITDA</b>	<b>23,290</b>	<b>23,171</b>	<b>(119)</b>
利益率	25.7%	24.6%	(1.1)%
<b>調整後EBITDA</b>	<b>通期</b>	<b>通期予想(修正後)</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>11,079</b>	<b>8,135</b>	<b>(2,943)</b>
IFRS導入費用	0	0	0
コンサルティング・フィー	24	0	(24)
中国免除申請関連費用	(198)	(68)	130
上場関連費用	345	0	(345)
<b>調整項目計</b>	<b>172</b>	<b>(68)</b>	<b>(240)</b>
<b>調整後EBITDA</b>	<b>23,462</b>	<b>23,103</b>	<b>(359)</b>
利益率	25.9%	24.5%	(1.4)pts

(百万円)	FY2024/12	FY2025/12	増減
	通期	通期予想(修正後)	
<b>調整後営業利益</b>			
<b>営業利益</b>	<b>18,367</b>	<b>18,145</b>	<b>(222)</b>
PPA償却費	2,269	2,038	(231)
コンサルティング・フィー	24	0	(24)
中国免除申請関連費用	(198)	(68)	130
上場関連費用	345	0	(345)
減損損失	109	0	(109)
<b>調整項目計</b>	<b>2,550</b>	<b>1,970</b>	<b>(580)</b>
<b>調整後営業利益</b>	<b>20,917</b>	<b>20,115</b>	<b>(802)</b>
利益率	23.1%	21.4%	(1.7)pts
<b>調整後当期利益</b>			
<b>当期利益</b>	<b>13,615</b>	<b>12,307</b>	<b>(1,308)</b>
PPA償却費	2,269	2,038	(231)
コンサルティング・フィー	24	0	(24)
中国免除申請関連費用	(198)	(68)	130
上場関連費用	345	0	(345)
減損損失	109	0	(109)
<b>調整項目計</b>	<b>2,550</b>	<b>1,970</b>	<b>(580)</b>
調整項目に対する税金等調整	(798)	(650)	148
<b>調整後当期利益</b>	<b>15,368</b>	<b>13,627</b>	<b>(1,741)</b>
利益率	17.0%	14.5%	(2.5)pts

## Appendix – トランプ政策による影響と対策

---

環境変化

## 関税増の直接的影響

- 2025年リガクグループ売上の約26%が米国顧客向け
  - 約19%が米国への輸出製品、約7%が米国内製造製品
    - 米国子会社経由で販売(主に **多目的分析機器**): 12%
    - 米国顧客へ直接販売(主に **半導体プロセス・コントロール**): 7%
- 関税率15%の場合、米国顧客への販売価格に対して想定されるコスト増幅：
 

<b>多目的分析機器</b>	約6~7.5%	<b>半導体プロセス・コントロール</b>	~15%
----------------	---------	-----------------------	------

想定アクション

## 【関税負担の軽減に向けた取り組み方針】

- 販売価格への転嫁(受注済と今後の受注案件双方)
- 商流の変更
- 既存米国拠点を活用した米国内での組立て+検査作業の拡大
- 米国製造部品/モジュールにおける免税措置の活用

➡ 関税の直接的な影響には対応可能

## 各種政策による間接的影響

- 米政府歳出削減による米ライフサイエンス、アカデミアセグメントにおける事業機会の減少
  - 合計21億円 (**多目的分析機器** 19億円、**サービス** 2億円) の影響を想定
  - リガク全体に占める売上高の割合：
 

米ライフサイエンス:	約1%	米アカデミア:	約6%
------------	-----	---------	-----
- 世界の景気悪化懸念による、顧客の投資意欲減退・延期

## 【需要のより大きな分野へのシフト】

### 多目的分析機器

- 米国におけるインダストリー分野へのアプローチ強化
- 米国以外での事業強化(アジア、中国)
- Pillar 3 戦略の加速

### 半導体プロセス・コントロール機器

- 開発/新分野ニーズの更なる深堀
- サプライチェーン多重化による創出機会の捕捉

# Appendix – 用語集

---

用語	説明
AXI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automated X-Ray Inspectionの略称。X線を用いた自動検査装置。電子基板や半導体内部の欠陥を非破壊で検出し、品質管理を効率化する</li> </ul>
CFET	<ul style="list-style-type: none"> <li>Complementary FET(CFET)は、N型FETとP型FETを垂直方向に積層して統合する次世代の半導体デバイス技術 現在主流のFinFETやGAA(Gate-All-Around)FETに続く技術として期待されている</li> </ul>
CoWoS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chip on Wafer on Substrateの略称。TSMCが開発した先進パッケージ技術の一つ。 複数のチップをシリコンインターポザー上に実装し、基板に搭載することで、高速・大容量のデータ処理と省スペース化を実現</li> </ul>
EUV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extreme Ultravioletの略称。波長が約13.5nmの紫外線を指し、半導体製造の露光プロセスで使用される光源技術</li> </ul>
GAA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gate-All-Aroundの略称。 トランジスタ技術の一種で、ゲートがすべての側面からチャンネルに接触、継続的な小型化を可能にするトランジスタ構造を指す</li> </ul>
GaN	<ul style="list-style-type: none"> <li>ガリウム(Ga)と窒素(N)で構成される化合物半導体材料</li> </ul>
GI-SAXS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grazing Incidence Small-Angle X-ray Scatteringの略称。浅い角度の斜め方向からX線を照射し、 材料表面近くの微細構造を非破壊で解析する手法。薄膜や表面のナノスケール構造の評価に利用される</li> </ul>
HBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>High Bandwidth Memoryの略称。低消費電力かつ極めて広い帯域幅を持つ新型メモリチップ。 スタック内およびメモリとロジックの間の両方で、極めて広いデータチャンネルを提供する標準化された積層メモリ技術</li> </ul>
High-k/Metal Gate	<ul style="list-style-type: none"> <li>High-k材料とは高誘導率(high dielectric constant)を持つ材料のこと。 High-k/Metal Gateとは、High-k材料と金属ゲートを組み合わせた最新のトランジスタ構造を指す</li> </ul>
MiniFlex XpC	<ul style="list-style-type: none"> <li>X線回折(XRD)を用いて材料の結晶構造を分析するためのコンパクトな装置であるMiniFlexシリーズに比べ、 プロセス用途や自動化ラインとの連携を意識して開発されたモデル</li> </ul>

用語	説明
NEX CG II	<ul style="list-style-type: none"> <li>次世代偏光光学系エネルギー分散型蛍光X線分析装置。各種油類や液体、固体、金属、ポリマー、生体試料、粉末試料、ペースト試料、コーティング試料、薄膜試料など、さまざまな種類の試料の主成分および微量成分に対し、迅速に定性分析および定量分析や膜厚測定ができる</li> </ul>
ONYXシリーズ	<ul style="list-style-type: none"> <li>エネルギー分散型蛍光X線分析(EDXRF)技術と光学技術を組み合わせたハイブリッド型分析装置。半導体パッケージなどの多層構造を非破壊でインライン評価可能。微小部の成分分析や3次元形状の測定に対応</li> </ul>
Pillar 3戦略	<ul style="list-style-type: none"> <li>リガクが推進する「Lab to Fab戦略」のもと、多目的分析機器の活用領域を、研究開発用途から量産工程へと拡大・展開する取り組み</li> </ul>
SiC	<ul style="list-style-type: none"> <li>シリコン(Si)と炭素(C)で構成される化合物半導体材料</li> </ul>
SiGe	<ul style="list-style-type: none"> <li>シリコン(Si)にゲルマニウム(Ge)で構成される合金半導体材料</li> </ul>
TFXRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>半導体産業における薄膜特性の高精度な評価を目的としたX線回折(XRD)装置。特に、200mmおよび300mmの大口径ウェーハ上の薄膜の測定に対応しており、研究開発から製造プロセスのモニタリングまで幅広く利用されている</li> </ul>
T-SAXS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transmissive Small-Angle X-ray Scatteringの略称。透過型小角X線散乱法。物質にX線を透過させ、その散らばり方を分析することで、物質内部のナノメートルスケールの微細構造を非破壊で解析できる手法。半導体部品内部の微細な状態を詳しく確認する際に用いられる</li> </ul>
WFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wafer Fab Equipment の略称。ウェーハを回路形成・検査するプロセスにおける製造装置を指す</li> </ul>

用語	説明
XRF	<ul style="list-style-type: none"> <li>X-Ray Fluorescenceの略称。物質にX線を照射したときに発生する蛍光X線を利用して、定性分析や定量分析を行う元素分析手法</li> </ul>
XRTmicron	<ul style="list-style-type: none"> <li>高輝度X線光源と専用光学系を用いた高分解能・高速X線トポグラフィ装置。Si、SiC、GaNなどの単結晶材料に対応。結晶欠陥を非破壊、全自動で検出できることから、半導体生産の歩留まり向上に寄与できる</li> </ul>
XtaLAB Synergy ED	<ul style="list-style-type: none"> <li>リガクの単結晶X線構造解析の要素技術と日本電子の透過型電子顕微鏡の要素技術を組み合わせて作られた電子線回折装置。従来よりも微細な粉末状の結晶でも測定が可能。これまで解析が困難であった物質でも構造情報を得ることができる</li> </ul>
ZSX Primus III NEXT	<ul style="list-style-type: none"> <li>定評のある上面照射型の走査型X線分析装置。生産管理で広く使われてきた汎用モデル「ZSX PrimusIII+」の後継機</li> </ul>
ZSX Primus IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>4kWの強力なX線を用いて、物質に含まれる元素を詳しく調べる波長分散型のX線分析装置</li> </ul>
回折	<ul style="list-style-type: none"> <li>X線回折(XRD)。結晶試料にX線を照射するとき生じる回折パターンから試料の結晶構造情報を得る手法</li> </ul>
蛍光	<ul style="list-style-type: none"> <li>X線蛍光(XRF)。物質にX線を照射したときに発生する蛍光X線を利用して、定性分析や定量分析を行う元素分析手法</li> </ul>
電子密度トポグラフィ	<ul style="list-style-type: none"> <li>結晶内部の電子の分布(電子密度)を可視化する技術。これにより、材料の原子構造や結合の状態を詳細に調べることが可能</li> </ul>
ペロブスカイト太陽電池	<ul style="list-style-type: none"> <li>「ペロブスカイト構造」と呼ばれる結晶を使った次世代型の太陽電池。軽量・低コストで製造でき、高効率な発電が可能のため、シリコンに代わる有力な材料として研究・開発が進んでいる</li> </ul>